

1.25-2.5 Gbps InGaAs PIN PD Chip $\phi 55\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 2.5Gbps； $\phi 55\mu\text{m}$ 有效面积；高响应度；顶照式平面结构

应用领域

EPON ONU | 2.5Gbps 接收器 | 光纤数据通信

详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.95		A/W	$\lambda=1310-1550\text{nm}$
暗电流	I_D		0.05	0.3	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.30	0.5	pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		3.0		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		55		um	
芯片尺寸			220*220*120		um	L*W*H